■博士課程　論文発表会プログラム【令和8年3月修了】

【回路G】　期日：令和　8　年　1　月　15　日(木)　会場：南３号館２階第１会議室(　S3-201　)					
発表時刻	発表者	選択コース	主指導教員	副指導教員	論文題目
11:00　～　12:30	山崎　雄大	電気電子	岡田健一		A Study of Sub-THz Phased-Array Transceiverfor 100Gbps MIMO Mobile Communications
【回路G】　期日：令和８年１月６日(火)　会場：すずかけ台キャンパス　大学会館　集会室1					
15:00　～　17:00	菅谷　慎二	電気電子	伊藤浩之		ウェハボンド後スルーホール形成するビアラストTSVの半導体デバイスへの応用の研究
【回路G】　期日：令和　8　年　1　月　13　日(火)　会場：南9号館6階605会議室(　S9-605　)					
11:00　～　13:00	Wang Xiaolin	電気電子	白根篤史		A Study on Power-Efficient CMOS Phased-Array Transmitters for High Speed Satellite Communications
【デバイス】　期日：令和 8年　1月　6日(火)　会場：第1会議室(S3-201号室)　(大岡山)					
15:30　～　17:00	松岡 竜太郎	電気電子	小寺哲夫		Noise Evaluation Methods toward Semiconductor Quantum Computing (半導体量子コンピューティングに向けたノイズ評価手法)
【デバイス】　期日：令和８年１月13日(火)　会場：すずかけ台　大学会館　集会室１					
15:00　～　16:30	范　志遠	電気電子	渡辺正裕		Fundamental Study of Near-Infrared Quantum Cascade Lasers using Si/CaF2 Heterostructures on SOI Substrate
【物性】　期日：令和　8年　1月5日(月)　会場：電気電子系第1会議室(S3-201)					
13:00　～　15:00	Liu Min	電気電子	ファムナムハイ		Spin Hall effect magnetic field sensor
15:00　～　16:30	Zhang Ruixian	電気電子	ファムナムハイ		Study on topological insulator BiSb and CoFeB with perpendicular magnetic anisotropy for spin-orbit torque magnetoresistive random access memory(スピン軌道トルク磁気抵抗メモリに向けたトポロジカル絶縁体BiSbと垂直磁化CoFeBの接合に関する研究)
【物性】　期日：令和　8年　1月20日(火)　会場：電気電子系第1会議室(S3-201)					
10:30　～　12:00	西山 黎	電気電子	ファムナムハイ		Optical characterization and device application of BiSb in the infrared region (BiSbの赤外領域における光学特性評価とデバイス応用)
【物性】　期日：令和　8年　1月8日(木)　会場：すずかけ台大学会館集会室１					
15:00　～　17:00	三柴 健太郎	電気電子	飯野裕明		Study on Functional Alkynylborane Compounds for Stable Organic Semiconductor Materials (安定な有機半導体材料を目指した機能性アルキニルボラン化合物の研究)
【電力】　期日：令和8年1月6日(火)　会場：南2号館 S2-203講義室 (S222)					
15:30　～　17:00	馬野 叶悟	電気電子コース	藤田英明		素子直列方式の電圧分担均等化を目的とするアクティブゲートドライブに関する研究